

Te 을 기본으로 한 박막에서의 열화에 관한 연구.

송준식<sup>\*</sup>, 문학, 이현웅, 이정종, 정용배  
광운대학 전자재료공학과

Degradation of the Te-based thin films.

## 1. 서 론

최근 광기록 매체 (Optical recording media) 를 개발하기 위한 연구가 활발하게 진행되고 있다. 일반적으로 광기억소자 (Optical memory device) 는 많은 양의 정보를 고밀도로 광기억 시킬 수 있어야 하고 기록 및 재생시 laser 에 대한 감도가 좋아야 하며 신호 대 잡음비 (Signal-to-noise ratio) 가 커야 한다. 또한 낮은 용적, 낮은 열학산도, 높은 점도를 가져야 한다. 그리고 기록수명 (Lifetime) 이 중요 안요소이다. Te 박막은 가장 광범위하게 연구된 광기록 매체이다. Te 박막의 문제점은 습기분위기에서 박막이 불안정하여 수명이 짧은 단점을 가지고 있다. 그러나 Te 에 Se을 첨가하면 습기분위기에서도 안정한 박막을 얻을 수 있다. 또한 Te-Se 계 박막에 Sb, Bi 를 첨가하면 결정립 (Crystallite) 이 작은 박막을 얻을 수 있으며, laser 에 의한 hole 형성후 신호를 일률 때 잡음 (noise) 을 작게 할 수 있다.

본 연구에서는 기본특성으로  $\text{Te}_{86}\text{Se}_{14}$ ,  $(\text{Te}_{86}\text{Se}_{14})_{100-x}\text{Bi}_x$ ,  $(\text{Te}_{86}\text{Se}_{14})_{100-x}\text{Sb}_x$  ( $x=10, 30, 50$ ) 박막에서의 열화 (degradation) 에 대해 연구하여 실제 응용에서 laser 로 신호를 기억시켰을 때 저장 수명 (Archival lifetime) 을 길게하여 광기억소자로서의 가능성을 알아 보고자 한다.

## 2. 실험

본 실험에서 사용한 시료는  $\text{Te}_{86}\text{Se}_{14}$ ,  $(\text{Te}_{86}\text{Se}_{14})_{100-x}\text{Bi}_x$ ,  $(\text{Te}_{86}\text{Se}_{14})_{100-x}\text{Sb}_x$  ( $x=10, 30, 50$ )이며 시료제작은 평방한 Te, Se, Bi, Sb 를 석영관에 넣어  $4 \times 10^{-5}$  Torr 정도에서 진공봉입안 후에 25시간 이상 가열하여 굽 냉하였다. 제작된 시료를 전자빔 증착기 (Electron-Beam Evaporator) 를 사용하여  $1 \times 10^{-6}$  Torr 정도의 진공에서  $5 \text{ \AA/sec}$  의 증착속도,  $300 \text{ \AA}$  두께로 PMMA (PolyMethylMethacrylate) 기판위에 박막을 만들었으며 이를 80% RH/66°C 의 양온양습분위기와 100 W 텅스텐램프로 표면온도를 85°C 정도로 유지시킨 분위기,  $7.6 \times 10^{-2}$  Torr 정도의 진공 분위기에 각각 넣어 20일 동안 자외선-가시광선 분광광도계 (UV-Visible Spectrophotometer) 로 투과도를 측정하여 열화정도를 측정하였다. 그리고 각각의 박막형성직후 흡수율을 자외선-가시광선 분광광도계로 측정하였다.

## 3. 결과 및 고찰

그림 1은  $\text{Te}_{86}\text{Se}_{14}$ ,  $(\text{Te}_{86}\text{Se}_{14})_{100-x}\text{Bi}_x$ ,  $(\text{Te}_{86}\text{Se}_{14})_{100-x}\text{Sb}_x$  ( $x=10, 30, 50$ )을 PMMA 기판 위에  $5 \text{ \AA/sec}$ 의 비율로 두께  $300 \text{ \AA}$  으로 증착한 다음 80% RH/66°C 분위기인 양온양습기 속에 넣고 20일 동안 다이오드레이저 파장인 830 nm 에서의 투과도를 측정한 결과이다. 박막형성 직후부터 1-2 일 사이에 약간의 투과율의 변화가 일어나고 그 이후에 포화되는 것으로 보아 각각의 박막이 습기분위기에서

안정된 것을 발견할 수 있었다. 그림 2는  $\text{Te}_{86}\text{Se}_{14}$ ,  $(\text{Te}_{86}\text{Se}_{14})_{100-x}\text{Bi}_x$ ,  $(\text{Te}_{86}\text{Se}_{14})_{100-x}\text{Sb}_x$  ( $x=10, 30, 50$ ) 을 PMMA 기판위에  $5 \text{ \AA/sec}$  의 비율로 두께  $300 \text{ \AA}$  으로 증착한 후  $100 \text{ W}$  텅스텐램프로 표면온도를  $85^\circ\text{C}$  정도로 유지된 분위기에서의 20일 동안의 투과도를 측정한 것이다.

여기에서 각각의 박막이 대기중에서 온도가 높아짐에 따라 열화가  $80\% \text{RH}/66^\circ\text{C}$  습기분위기에서 약 비슷한 속도로 일어남을 알 수 있었다.

그림 3에 나타나 있듯이 각각의 박막은 진공중에서 거의 투과율의 변화가 없는 것으로 보아 가장 안정된 상태인 것을 나타내고 있다.

그림 4는  $\text{Te}_{86}\text{Se}_{14}$ ,  $(\text{Te}_{86}\text{Se}_{14})_{70}\text{Bi}_{30}$ ,  $(\text{Te}_{86}\text{Se}_{14})_{70}\text{Sb}_{30}$  을  $5 \text{ \AA/sec}$  의 증착율로 PMMA 기판위에 두께  $300 \text{ \AA}$  으로 증착한 박막을  $80\% \text{RH}/66^\circ\text{C}$  인 항온항습분위기,  $100 \text{ W}$  텅스텐램프를 조사하여 표면 온도를  $85^\circ\text{C}$  정도로 유지시킨 분위기,  $7.6 \times 10^{-2} \text{ Torr}$  정도의 진공분위기에서 20일동안 측정한 투과도이다. 여기에서 각각의 박막이 각각의 분위기에서 안정된 특성을 나타낸을 알 수 있었다.

그림 5는 Te,  $\text{Te}_{86}\text{Se}_{14}$ ,  $(\text{Te}_{86}\text{Se}_{14})_{100-x}\text{Sb}_x$ ,  $(\text{Te}_{86}\text{Se}_{14})_{100-x}\text{Bi}_x$  ( $x=10, 30, 50$ ) 을  $5 \text{ \AA/sec}$  로 PMMA 기판위에  $300 \text{ \AA}$  의 두께로 증착시킨 직후의 흡수도 (absorbance) 이다. 각각의 박막이  $488 \text{ nm}$  의 짧장부근에서 높은 흡수를 나타내고 있다.

#### 4. 맷 음 말

$\text{Te}_{86}\text{Se}_{14}$ ,  $(\text{Te}_{86}\text{Se}_{14})_{100-x}\text{Bi}_x$ ,  $(\text{Te}_{86}\text{Se}_{14})_{100-x}\text{Sb}_x$  ( $x=10, 30, 50$ ) 박막이 습기분위기에서 안정됨을 알 수 있었으며,  $488 \text{ nm}$  의 짧장부근에서 높은 흡수를 나타내었다. 각각의 박막의 증착직후의 표면사진과 각각의 분위기에서 20일이 지난 후의 표면사진 및 각각의 박막의 반사율 측정도 진행중에 있다. 또한 각각의 박막에 laser 를 사용 hole 을 형성하여 hole 모양 분석에 대한 연구도 진행중에 있다.

#### 5. Reference

- R.A. Bartolini, A.E. Bell, et al, IEEE spectrum 15, 20 (1978)
- K. Bulthuis, M. Carasso, J. Heemskerk et al, IEEE Spectrum 16, 26 (1979)
- I.M. Issa and S.A. Awad, J. Phys. Chem. 58, 948 (1954)
- D. Lou, G. Blom and G. Kenny, J. Vac. Sci. Technol. 18, 78 (1981)
- 전기재료 학술 발표, 4-21-19, 1986년 10월, 송준석, 이종기, 이영종, 정홍배.

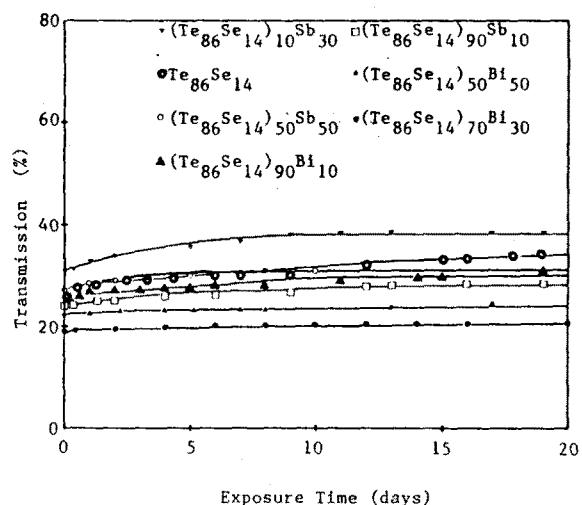


Fig. 1. Light transmission(at  $830\text{nm}$ ) as a function of exposure time in a  $18\% \text{RH}/66^\circ\text{C}$  atmosphere for  $300 \text{ \AA}$  thick  $\text{Te}_{86}\text{Se}_{14}$ ,  $(\text{Te}_{86}\text{Se}_{14})_{100-x}\text{Se}_x$ ,  $(\text{Te}_{86}\text{Se}_{14})_{100-x}\text{Bi}_x$  ( $x=10, 30, 50$ ) films deposited on PMMA at  $5 \text{ \AA/sec}$ .

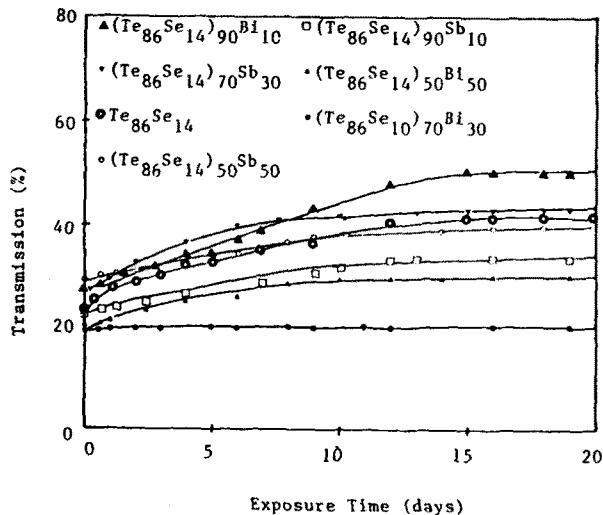


Fig. 2. Light transmission (at 830nm) as a function of exposure time in a low tungsten lamp irradiation atmosphere for 300Å thick Te<sub>86</sub>Se<sub>14</sub>, (Te<sub>86</sub>Se<sub>14</sub>)<sub>100-x</sub>Sb<sub>x</sub>, (Te<sub>86</sub>Se<sub>14</sub>)<sub>100-x</sub>Bi<sub>x</sub> (x=10, 30, 50) film deposited on PMMA at 5Å/sec.

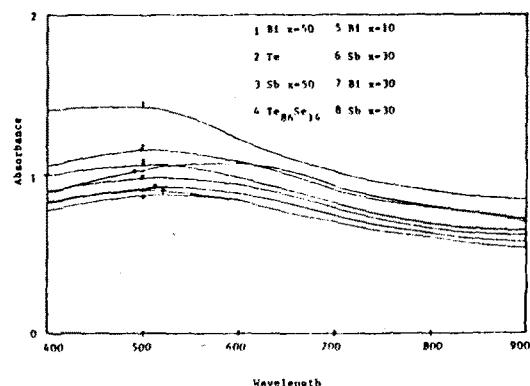


Fig. 5. Light absorbance of a 300Å thick Te, Te<sub>86</sub>Se<sub>14</sub>, (Te<sub>86</sub>Se<sub>14</sub>)<sub>100-x</sub>Sb<sub>x</sub>, (Te<sub>86</sub>Se<sub>14</sub>)<sub>100-x</sub>Bi<sub>x</sub> (x=10, 30, 50) films deposited at 5Å/sec.

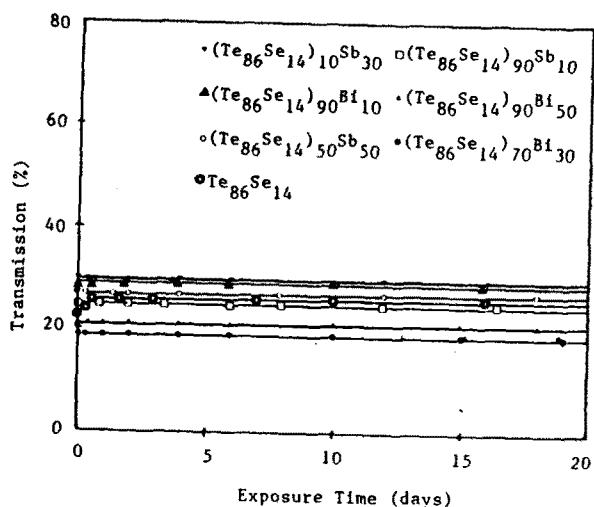


Fig. 3. Light transmission (at 830nm) as a function of exposure time in a 7.6 10<sup>-2</sup> Torr atmosphere for 300Å thick Te<sub>86</sub>Se<sub>14</sub>, (Te<sub>86</sub>Se<sub>14</sub>)<sub>100-x</sub>Sb<sub>x</sub>, (Te<sub>86</sub>Se<sub>14</sub>)<sub>100-x</sub>Bi<sub>x</sub> (x=10, 30, 50) film deposited on PMMA at 5Å/sec.